重水素プラズマ曝露された照射欠陥導入タングステンの 昇温脱離スペクトルの解析

## Analysis of thermal desorption spectra of ion-damaged tungsten exposed to deuterium plasma

<u>田中裕樹</u><sup>1</sup>、伊能俊太朗<sup>1</sup>、坂本瑞樹<sup>1</sup>、渡邉英雄<sup>2</sup>、大矢恭久<sup>3</sup>、桜田翔大<sup>3</sup>、藤田啓恵<sup>3</sup>、 寺門明紘<sup>1</sup>、芦川直子<sup>4</sup>、時谷政行<sup>4</sup>、江角直道<sup>1</sup>、中嶋洋輔<sup>1</sup> TANAKA Hiroki<sup>1</sup>, INO Shuntaro<sup>1</sup>, SAKAMOTO Mizuki<sup>1</sup>, WATANABE Hideo<sup>2</sup>, OYA Yasuhisa<sup>3</sup> et al.

<sup>1</sup>筑波大学プラズマ研究センター、<sup>2</sup>九州大学応用力学研究所、<sup>3</sup>静岡大学、<sup>4</sup>核融合科学研究所 <sup>1</sup>Plasma Research Center, Tsukuba University, <sup>2</sup>Research Institute for applied mechanics, Kyushu University, <sup>3</sup>Shizuoka University, <sup>4</sup>National Institute for Fusion Science

ITER や DEMO では、安全性等の観点からトリチウ ム吸蔵量の低減が求められる。ITER のダイバータ板に は、炭素複合材よりも低損耗で水素同位体を吸蔵しに くいということから、タングステンが使用される。し かし、D-T 反応で生じる中性子がもたらすタングステ ン中の照射欠陥により、トリチウム吸蔵量が増加して しまう。中性子照射により損傷したタングステンのト リチウム吸蔵メカニズムを究明するために、高エネル ギーイオンや核分裂中性子を用いて損傷させたタング ステンの重水素吸蔵に関する研究が数多く行われてき た。本研究は、中性子照射による影響を銅イオン照射 で模擬し、タングステン中の照射欠陥が重水素吸蔵特 性に与える影響の評価を目的としている。

本研究では、10 mm × 10 mm × 1 mmの再結晶 W 試 料を使用した。再結晶 W 試料中に照射欠陥を形成する ために、2.4 MeV の Cu<sup>2+</sup>を照射量やフラックス、試料 温度を変えて試料に照射した。そして試料に対する重 水素プラズマ照射を、小型の PWI 模擬実験装置 APSEDAS[1]を用いて行った。試料に入射する重水素イ オンのエネルギーは約 30 eV、フラックスは約  $3.7 \times 10^{21}$ D m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>、フルエンスは  $2.0 \times 10^{25}$  D m<sup>2</sup> である。プラズ マ照射中の試料の表面温度は約 480 K だった。プラズ マ照射後、試料を昇温脱離スペクトル測定装置内に移 し、プラズマ照射終了から 3 時間後に昇温速度 1 K/s で 試料を加熱し、昇温脱離スペクトル測定を行った。

図1に室温で銅イオンをフラックス 5×10<sup>15</sup> m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>で 照射した試料の昇温脱離スペクトルを示す。このグラ フより、3つの脱離ステージが存在し、銅イオン照射に よってステージ C での脱離量が最も高い割合で増加し たことが分かる。また、2.4 MeV の銅イオン室温照射に よる再結晶 W 中の欠陥形成が TEM で観察され、ナノ ボイドや原子空孔の集合体、転位ループの存在が確認 されている[2]。このことから、脱離ステージ C は、ナ ノボイドや原子空孔の集合体に対応すると考えられる。 また、室温で 4 dpa まで銅イオン照射された試料の昇 温脱離スペクトルを Hydrogen Isotope Diffusion and Trapping (HIDT)シミュレーションコード[3]で解析した ところ、高温側のピークに対応する捕獲サイトと重水 素原子の結合エネルギーが 1.4-1.5 eV という初期的結 果が得られた。

図 2 に銅イオンを室温照射された試料の重水素吸蔵 量の dpa 依存性を示す。銅イオンをフラックス 5×10<sup>15</sup> m<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>で照射された試料の重水素吸蔵量は0.4 dpa以上 で飽和傾向を示している。一方で、低フラックスで銅 イオンを室温照射された試料の重水素吸蔵量は 2 dpa まで単調増加している。このことから、高エネルギー イオンのフラックスが異なる場合、イオン照射中の欠 陥形成プロセスに違いが生じる可能性が考えられる。

銅イオンのフラックス 5×10<sup>15</sup> m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>において室温・ 500 K・873 K で照射された試料の重水素吸蔵量は、銅 イオン照射温度が上がるにつれて減少した。試料の温 度が高くなることにより、銅イオン照射中の欠陥形成 が抑制されることが示唆される。



図 1: 室温で銅イオン照射された試料と 0dpa 試料の昇 温脱離スペクトル



図 2:異なるフラックスで銅イオンを室温照射された 試料の重水素吸蔵量の dpa 依存性

参考文献:

- [1] M. Sakamoto et al., Phys. Scr. T138 (2009) 014043
- [2] H. Watanabe et al., J. Nucl. Mater. 455 (2014) 51-5
- [3] Y. Oya et al., J. Nucl. Mater. 461 (2015) 336-340